04 Определение термодинамических параметров плазмы алюминиевого Х-пинча

© А.П. Артёмов, А.В. Федюнин, С.А. Чайковский, В.И. Орешкин, И.В. Лавринович, Н.А. Ратахин

Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск E-mail: aap545@gmail.com

Поступило в Редакцию 6 июля 2012 г.

На малогабаритном импульсном генераторе с амплитудой тока 200 kA и временем нарастания 180 пѕ проведены эксперименты, в которых нагрузкой являлся Х-пинч, состоящий из четырех алюминиевых проволочек диаметром $35 \,\mu$ m. На основе экспериментальных данных и расчетов, выполненных с помощью ударно-излучательной модели, были определены параметры "горячей точки" Х-пинча в момент максимального сжатия (температура, плотность, погонная масса). Показано, что, во-первых, импульс мягкого рентгеновского излучения в Х-пинче появляется при почти полном вытекании вещества из "горячей точки", во-вторых, формирование "горячей точки" в Х-пинче протекает в условиях, близких к беннетовскому равновесию.

Х-пинч является разновидностью многопроволочной нагрузки импульсных генераторов тока, позволяющей создать источник мягкого рентгеновского излучения микронных размеров с наносекундной длительностью импульса. В первоначальной конфигурации, предложенной в 1982 г. [1] Х-пинч представлял собой две скрещенные между собой тонкие проволочки, установленные в межэлектродном зазоре сильноточного генератора, и получил свое название за внешнее сходство с буквой "Х". В дальнейшем в нагрузках такого типа стали использовать

1

четыре и большее число проволочек, при этом название "Х-пинч" сохранилось. В области перекрестия проволочек формируется горячая плазменная "точка" микронных размеров с временем жизни около 1 ns, являющаяся в настоящее время одним из самых ярких лабораторных источников излучения в мягком рентгеновском диапазоне 1 ÷ 10 keV [2]. Образование "горячей точки" происходит под действием электромагнитных сил и сопровождается вытеканием вещества из горячей области [3]. Процесс образования "горячей точки" может быть описан в приближении радиационной магнитной гидродинамики. В данном приближении могут быть получены решения, показывающие, что если ток генератора превышает некоторое критическое значение, то пинч неограниченно сжимается. Критический ток определяется балансом джоулева энерговклада и потерь на излучение. При превышении радиационных потерь над джоулевым энерговкладом пинч впадает в радиационный коллапс, который протекает в условиях, близких к беннетовскому равновесию. Последнее означает равенство магнитного и газокинетического давлений и выражается в виде:

$$kT = \frac{m_i I^2}{2c^2 m(1 + \langle Z \rangle)},\tag{1}$$

где I — ток через пинч, T — температура пинча, $\langle Z \rangle$ — средний заряд ионов, m — погонная масса пинча, m_i — масса атома; k — постоянная Больцмана; c — скорость света в вакууме. В случае полностью ионизованной плазмы, в которой доминирует тормозное излучение электронов, значение критического тока, который получил название тока Брагинского–Пизе [4], равно:

$$I_{BP}=0.22\sqrt{\lambda}(Z_n+1)/Z_n,$$

где I_{BP} в [MA]; $\lambda \approx 10$ — кулоновский логарифм; Z_n — заряд ядра. Ток I_{BP} не зависит ни от погонной массы пинча, ни от его радиуса и для дейтериевой плазмы составляет около 1.4 MA, а для алюминиевой приблизительно в два раза меньше. В случае не полностью ионизованной плазмы, когда радиационные потери определяются рекомбинационным излучением и излучением в спектральных линиях, критическое значение тока становится функцией погонной массы [5] и достигает минимума (десятки килоампер) при погонной массе пинча, равной:

$$m^* = 9.5\lambda \, \frac{A(Z_n+1)}{Z_n^4},$$
 (3)

где m^* в [µg/cm]; A — вес атома в атомных единицах массы. Для алюминия значение $m^* \approx 1 \,\mu$ g/cm, при массах меньших m^* значение критического тока резко растет и стремится к I_{BP} [5].

Далее в работе предствлена методика, позволяющая определить параметры "горячей точки" Х-пинча в момент максимального сжатия (температура, плотность, погонная масса) и сделать вывод о применимости условия беннетовского равновесия при формировании "горячей точки". Эксперименты проводились на малогабаритном имульсном генераторе [2,6] с амплитудой тока через нагрузку около 200 kA и временем нарастания 180 ns (рис. 1). В качестве нагрузки генератора использовался Х-пинч из четырех алюминиевых проволочек диаметром $35\,\mu$ m, угол наклона проволочек относительно оси Х-пинча составлял 35° . Типичные осциллограммы тока через Х-пинч и излучения Х-пинча представлены на рис. 1, *b*. Как видно из этого рисунка, в экспериментах длительность импульса излучения "горячей точки" Х-пинча составляла $1 \div 2$ ns.

Для определения параметров "горячей точки" использовалась методика [7,8], применявшаяся при исследовании Z-пинчей для определения температуры и плотности плазмы. Данная методика позволяет определить усредненные по времени и объему концентрацию ионов и температуру электронов плазмы. Она основана на сравнении экспериментально измеренных значений мощности К-излучения, отношения интенсивностей резонансных линий и размера источника со значениями, рассчитанными по стационарной ударно-излучательной модели (УИМ). В данной работе методика измерений [7,8] была несколько изменена подобно тому, как это было сделано в работе [9]. Электронная температура определялась по спаду континуума излучения. Полученные экспериментальные данные сравнивались с расчетами по стационарной УИМ [10]. В программе, в которой реализованы уравнения этой модели, три входных параметра: электронная температура; концентрация ионов; радиус излучающей области. Поэтому в экспериментах также использовались три независимых вида диагностики:

 измерение отношения сигналов двух фотодетекторов с различной спектральной чувствительностью (для определения температуры по наклону континуума);

 проекционная рентгеновская съемка (для определения размеров излучающей области);

— измерение мощности излучения в *К*-линиях алюминия с помощью вакуумного рентгеновского диода.



Рис. 1. Схема экспериментов (*a*); экспериментальные осциллограммы тока и импульса мягкого рентгеновского излучения (*b*).

Как отмечалось выше, температура плазмы пинча определялась с помощью отношения сигналов двух фотодетекторов (PD) на основе кремния (рис. 1, *a*). Детектор PD 1 находился за фильтром Teflon $30\,\mu\text{m}$ +



Рис. 2. Зависимость чувствительности датчиков излучения от энергии квантов.

+ Kimfol 2μ m + Aluminum 02μ m + Polypropylene 20μ m, a детектор PD 2 — за фильтром Pd3 μ m + Kimfol 2 μ m + Aluminum 0.2 μ m + Polypropylene 20 µm. Чувствительность детекторов с такими фильтрами в зависимости от энергий фотонов представлена на рис. 2. Из рис. 2 видно, что чувствительности обоих детекторов в области до 3.15 keV (край поглощения палладия) практичеки совпадают, а в более жесткой области чувствительность PD 1 оказывается значительно выше. Кроме того, чувствительности обоих датчиков к излучению наиболее интенсивных спектральных линий гелио- и водородоподобных ионов алюминия значительно ниже, чем для квантов с энергией $h\nu > 2.09 \,\mathrm{keV}$ (рекомбинационный скачок гелиеподобного иона алюминия). Следовательно, данные датчики чувствительны только к непрерывному спектру излучения (тормозное и рекомбинационное) ионов алюминия. Сигнал каждого из датчиков PD определяется формой спектра излучения и чувствительностью датчика:

$$U_{PCD} = G \int s(E)f(E)dE, \qquad (4)$$

где f(E) — спектр излучения, s(E) — спектральная чувствительность датчиков, G — геометрический коэффициент в полной чувствительности детектора. В предположении, что в плазме устанавливается максвелловское распределение электронов, спектр непрерывного излучения

Параметры "горячей точки" алюминиевого Х-пинча

Диаметр, µm	Длина, <i>µ</i> m	$T^{hp},$ eV	$P^{K-line},$ MW	n_i^{hp} , cm ⁻³	m^{hp} , μ g/cm	$m_0,$ μ g/cm
14 ± 3	28 ± 5	350 ± 50	50 ± 10	$(3\pm1)\cdot10^{21}$	0.25 ± 0.15	125

описывается экспоненциальной зависимостью от энергии кванта:

$$f(E) \propto \exp\left(-\frac{E-E_1}{T}\right),$$
 (5)

где E_1 — энергия рекомбинационного скачка. Расчет, выполненный с учетом (4) и (5), показал, что отношение сигналов датчиков сильно зависит от температуры пинча, поэтому использование отношения сигналов для определения температуры "горячей точки" является корректным. Из полученного в экспериментах отношения сигналов двух фотодетекторов была определена температура плазмы в "горячей точке" (см. таблицу), которая равна $T^{hp} = 350 \pm 50$ eV.

Для определения радиуса и длины источника рентгеновского излучения использовалась рентгеновская камера (рис. 1), с помощью которой прямым проецированием на детектор были получены теневые изображения тест-объекта в рентгеновском излучении. Тест-объект представлял собой сетку из скрещенных под прямым углом вольфрамовых проволочек диаметрами 6, 12 и 30 µm, которая располагалась на расстоянии 4 cm от источника рентгеновского излучения. Изображение тест-объекта фиксировалось на фотопленке, установленной за фильтром Kimfol 2μ m + Aluminuim 0.2μ m + Polypropylene 24μ m. С учетом коэффициента пропускания это позволило получить изображения тестобъекта в спектральном диапазоне E > 1.5 keV. Конфигурация проекционной схемы обеспечивала 20-кратное увеличение. В идеализированном случае, когда объект проецируется на пленку точечным источником излучения, получается тень с четкими краями. Если источник излучения конечных размеров, то распределение интенсивности на краю тени имеет плавно спадающий характер, а изображение объекта на пленке становится шире. По правилам геометрической оптики размер источника излучения связан с уширением изображения объекта. Размер источника излучения находился из разницы между шириной экспериментально



Рис. 3. Рентгеновское изображение тест-объекта и денситограмма изображения вертикальной вольфрамовой проволочки диаметром 12 µm.

полученного и рассчитанного для точечного источника распределений интенсивности в плоскости изображения на уровне 10% от максимума плотности почернения.

На рис. 3 показано экспериментально полученное в рентгеновском излучении теневое изображение тест-объекта, из которого видно, что диаметр источника излучения меньше его длины, так как изображения вертикальных проволочек более четкие по сравнению с изображениями горизонтальных проволочек. На рис. 3 также приведена денситограмма изображения одной из вертикальных проволочек тест-объекта. Для сравнения на рис. 3 линиями показана ширина теневого изображения для точечного источника. Значения диаметра и длины источника рентгеновского излучения приведены в таблице.

Концентрация ионов в "горячей точке" определялась с помощью измерений мощности излучения в *К*-линиях алюминия. Для этого использовался вакуумный рентегновский диод (ВРД) с медным катодом, который находился за фильтром Kimfol 2 μ m + Al 0.2 μ m + +Polypropylene 24 μ m и имел максимум чувствительности в диапазоне энергий квантов 1.5 ÷ 2.7 keV (рис. 2).

Измерив сигнал ВРД, мощность излучения можно рассчитать по формуле:

$$P = \frac{U}{R} \frac{16\pi D^2}{\pi d^2} \frac{1}{S} \frac{1}{Tr}$$

где U — амплитуда сигнала ВРД, R — сопротивление измерительного тракта, D — расстояние от источника до детектора, d — диаметр катода ВРД, S — чувствительность датчика за фильтром, Tr — коэффициент пропускания сетки (анода ВРД). Исходя из сигнала ВРД (рис. 1, a), была определена мощность K-излучения (P^{K-line}) в диапазоне энергий квантов $hv = 1.5 \div 2.7$ keV, значения которой приведены в таблице. При известной экспериментальной мощности излучения концентрация ионов определялась из сравнения P^{K-line} со значениями мощности, рассчитанными по стационарной ударноизлучательной модели [7]. В расчетах температура и радиус источника излучения принимались равными значениям, приведенным в таблице. Определенная таким образом концентрация ионов оказалась равной $n_i^{hp} = (3 \pm 1) \cdot 10^{21}$ cm⁻³, что при температуре 350 eV соответствует значениям теплового давления приблизительно 25 Mbar. Погонная масса пинча в "горячей точке" составила $m^{hp} = 0.25 \pm 0.15 \,\mu$ g/ст.

Обсудим результаты экспериментов. Следует отметить, что в финале сжатия погонная масса Х-пинча в области "горячей точки" m^{hp} оказалась много меньше начальной погонной массы Х-пинча, которая составляла $m_0 = 125 \,\mu$ g/cm. Имульс мягкого рентгеновского излучения в Х-пинче появляется при почти полном вытекании вещества из "горячей точки". Так как ток через пинч в момент максимума излучения составлял 125 kA (рис. 1, *a*), то есть $< I_{BP}$, а $m^{hp} \leq m^*$, то излучение в "горячей точке" формируется в момент, когда параметры последней находятся вблизи границы области радиационного коллапса. За границей области радиационного коллапса газокинетическое давление больше магнитного, что должно приводить к остановке сжатия.

Далее, с помощью (1) проверим выполняется ли в "горячей точке", Х-пинча условие беннетовского равновесия. При температуре $300 \div 400 \text{ eV}$ алюминиевая плазма состоит в основном из гелиоподобных ионов, поэтому в оценках средний заряд принимался $\langle Z \rangle = 12$. Используя значение $T^{ph} = 350 \pm 50 \text{ eV}$ (см. таблицу), из выражения (1) получим, что для соблюдения условия беннетовского равновесия погонная масса пинча должна равняться $0.45 \pm 0.06 \,\mu$ g/сm. Это хорошо согласуется с погонной массой "горячей точки" Х-пинча m^{hp} . Исходя

из этого, можно сделать вывод, что формирование "горячей точки" в Х-пинче протекает в условиях, близких к беннетовскому равновесию, при этом через "горячую точку" микронных размеров протекает значительная доля тока генератора.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 10-02-00938-а, 12-08-00868-а).

Список литературы

- [1] Захаров С.М., Иваненков Г.В., Коломенский А.А. и др. // Письма в ЖТФ. 1982. Т. 8. С. 1060.
- [2] Месяц Г.А., Шелковенко Т.А. Иваненков Г.В. и др. // ЖЭТФ. 2010. Т. 138.
 В. З. С. 411–420.
- [3] Вихрев В.В., Брагинский С.И. Вопросы теории плазмы. М.: Атомиздат, 1980. В. 10. С. 243–318.
- [4] Брагинский С.И. // ЖЭТФ. Т. 33. В. 39. С. 645.
- [5] Орешкин В.И. // Изв. ВУЗов. Физика. 1997. Т. 12. С. 76-84.
- [6] Ратахин Н.А., Федущак В.Ф., Эрфорт А.А. и др. // Изв. ВУЗов. Физика. 2007. Т. 50. В. 2. С. 87–92.
- [7] Coulter M.C., Whitney K.G., Thornhill J.W. // J. Quant. Spectrosc. Radiant. Transfer. 1990. V. 44. P. 443–456.
- [8] Чайковский С.А., Сорокин С.А. // Изв. ВУЗов. Физика. 1999. Т. 42. В. 12. С. 75–80.
- [9] Sishlov A.V., Baksht R.B., Chaikovsky S.A. et al. // Proc. 13th Symposium on High Current Electronics. Tomsk, Russia. 2004. P. 319–322.
- [10] Орешкин В.И. // Изв. ВУЗов. Физика. 1995. Т. 38. В. 12. С. 6–15.